



## Lagenaufbau

Ebe	ne	Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Тур
1	( A	Cu+galv.Cu Tr-Lam	1,514	18+25	
2		Cu+galv.Cu	1,014	18+25	
	35 35				
	Basism	aterialdicke:	1,55	+/- 10 %	
G	esamtdicke inkl. galv. Cu u. Löts	stoppmaske:	1,66	+/- 10 %	

## Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe
- abhängig von gewählter Kupferdicke abweichende Isolationsdicke

## Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 200 µm					
(vido)	Viapad-Ø	≥ 500 µm					
Leiterbild Außenlagen							
Standard	Leiterbreite bei 18 μm Grundkupfer Leiterabstand bei 18 μm Grundkupfer	≥100 µm ≥ 120 µm					
	Leiterbreite bei 35 μm Grundkupfer Leiterabstand bei 35 μm Grundkupfer	≥ 130 µm ≥ 175 µm					
	Leiterbreite bei 70 μm Grundkupfer Leiterabstand bei 70 μm Grundkupfer	≥ 190 µm ≥ 240 µm					





Leiterbreite bei 105 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 105 µm Grundkupfer ≥ 250 µm ≥ 320 µm